СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СХЕМ ТЕРМООХЛАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ В УСТАНОВКЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ НЕРАВНОВЕСНОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ

© 2008 Б.А. Соломин, А.М. Ходаков

Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники РАН

Произведён теплофизический расчёт двух схем охлаждающих устройств на элементах Пельтье, работающих в динамическом режиме. Показано преимущество одной из схем.

Для исследования низкотемпературных свойств жидкостей в условиях неравновесной термодинамики удобно использование компактных охлаждающих устройств на базе элементов Пельтье. Основными требованиями к таким установкам являются: достаточно высокий темп охлаждения и нагрева проб жидкостей; предельно низкая минимально достижимая температура пробы на интервале времени не более 3 ÷ 5 минут; низкая потребляемая мощность; возможность внешнего автоматического управления режимами охлаждения и нагрева проб. Была разработана автономная, экономичная и эффективная система охлаждения и нагрева проб жидкостей с воздушным принудительным охлаждением, использующая две системы элементов Пельтье с независимым и регулируемым питанием и аккумулятор холода, находящийся между ними. Одна из систем элементов Пельтье находится в тепловом контакте с кюветой для исследуемой пробы и служит для её охлаждения или нагрева с заданной скоростью. В свою очередь она имеет тепловой контакт с аккумулятором холода, который на период измерения низкотемпературных свойств исследуемых жидкостей имеет достаточно низкую температуру, обеспечивающую требуемый тепловой режим элементов Пельтье в условиях максимального охлаждения пробы. Низкая начальная температура аккумулятора холода обеспечивается второй системой элементов Пельтье в промежуток времени между периодами охлаждения пробы [1]. Возможны различные функциональные схемы подобных систем охлаждения. Расчёт термоохлаждающих устройств в нестационарном режиме необходим как при

выборе схемы термоохлаждения, с точки зрения достижения заданной температуры, так и времени её достижения. Однако строгое решение поставленной задачи вызывает определённые трудности. Теоретически и экспериментально нами исследовались по термической и энергетической эффективности две нижеописанные схемы.

Тепловой расчёт блока охлаждения устройства, предназначенного для исследований низкотемпературных теплофизических свойств жидкостей, проводился согласно представленных на рис. 1 и 2 схем установок. Схема 1 содержала аккумулятор холода 6, представляющий собой параллелепипед с большой величиной коэффициента удельной теплоёмкости, который охлаждался двумя боковыми термоэлектрическими модулями 8 до начальной температуры Т₀. Далее включалась вторая ступень охлаждения непосредственно жидкости, которая состояла из термоэлектрического модуля 3, расположенного на верхней грани параллелепипеда аккумулятора. Охлаждение жидкости осуществлялось с заданной скоростью изменения температуры v. В схеме 2 аккумулятор холода отсутствовал, а вместо него находилась термоаккумулирующая пластина 4, которая располагалась между двумя термоэлектрическими преобразователями 3 и 5. Обе схемы адиабатически теплоизолировались. Горячие грани термоэлементов 8 в схеме 1 и 7 в схеме 2 охлаждались радиаторами принудительного охлаждения, с известной пропускной способностью по воздуху Р.

Для определения зависимости температуры жидкости от времени необходимо предварительно решить нестационарные задачи



Рис. 1. Схема установки 1:

1 – кювета, 2 – охлаждаемая жидкость, 3, 8 – термоэлектрические модули, 4 – пластина крепления модуля, 5 – радиатор принудительного охлаждения, 6 – аккумулятор холода, 7 – теплоизоляция





1 – кювета, 2 – охлаждаемая жидкость, 3, 7 – термоэлектрические модули, 4 – термоаккумулирующая пластина, 5 – радиатор принудительного охлаждения, 6 – теплоизоляция

теплопроводности, определяющие распределение температуры в аккумуляторе холода и термоаккумулирующей пластине, которое возникает при включении второй ступени охлаждения и работы её горячей грани в качестве источника тепла. Так как задачи эти являются симметричными в декартовой системе координат, то рассматривается 1/4 часть соответствующих геометрий (рис.3). При этом координаты в областях П и П₁ меняются следующим образом:

$$\Pi = \begin{cases} 0 \le x \le L_x, \\ 0 \le y \le L_y; \end{cases} \Pi_I = \begin{cases} 0 \le x \le l_x, \\ 0 \le y \le l_y; \\ 0 \le z \le L_z, \end{cases}$$
(1)

где L_x , L_y , $L_z - 1/2$ длины, ширины и высота аккумулятора холода или термоаккумулирующей пластины соответственно; $l_x l_y - 1/2$ длины и ширины термоэлемента.

Обозначим, T_{ak} - температуру аккумулятора или термоаккумулирующей пластины, а через $T_{c1}(t)$ – температуру холодной грани термоэлектрического модуля 1-ой ступени, причём $T_{c1}(0) = T_0$. Уравнение теплопроводности будет

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \Delta_{x,y,z} T , \qquad (2)$$

где $T = T_{ak} - T_{cl}$, *а* – коэффициент температуропроводности аккумулятора или термоаккумулирующей пластины.

1-я задача (аккумулятор холода).

Начальное условие:

$$T(x, y, z, 0) = 0.$$
 (3)

(7)



Граничные условия:

$$T\big|_{x=0,L_x} = 0, \quad \frac{\partial T}{\partial y}\Big|_{y=0,L_y} = 0, \quad (4)$$

$$-\lambda \frac{\partial T}{\partial z}\Big|_{z=0} = \begin{cases} q(t), ecnu(x, y) \in \Pi_{1}, \\ 0, ecnu(x, y) \in \Pi - \Pi_{1}, \\ \frac{\partial T}{\partial z}\Big|_{z=L_{z}} = 0, \end{cases}$$
(5)

где q(t) – плотность теплового потока от горячей грани термоэлектрического модуля 2ой ступени. Задача решалась с использованием преобразований Фурье и Лапласа [2] и её решение имеет вид

$$T(x,y,z,t) = \frac{2q(t)L_z}{L_x L_y \lambda} \left[\left(I - \frac{z}{L_z} \right)^2 - \frac{I}{3} \right] \sum_{m,n=1}^{\infty} B_{nn0} \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) \cos\left(\frac{m\pi y}{L_y}\right) + \frac{8a}{\lambda L_x L_y L_z} \otimes \sum_{k=0,m,n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} B_{nmk} \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) \cos\left(\frac{m\pi y}{L_y}\right) \cos\left(\frac{k\pi z}{L_z}\right) \int_0^t q(\tau) \exp\{-a\gamma_{nmk}(t-\tau)\} d\tau,$$
(6)

где

$$B_{nmk} = \frac{L_x L_y}{nm\pi^2} \left(1 - \cos\left(\frac{n\pi l_x}{L_x}\right) \right) \sin\left(\frac{m\pi l_y}{L_y}\right), \text{ если } k \neq 0$$
и

$$B_{nmk} = \frac{L_x L_y}{2 nm \pi^2} \left(1 - \cos\left(\frac{n \pi l_x}{L_x}\right) \right) \sin\left(\frac{m \pi l_y}{L_y}\right), \text{ если } k = 0$$

$$\gamma_{nmk} = \left(\frac{n \pi}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{m \pi}{L_y}\right)^2 + \left(\frac{k \pi}{L_z}\right)^2.$$

2-я задача (термоаккумулирующая пластина). Начальное условие: T(x, y, z, 0) = 0.

Граничные условия:

$$\left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=0,L_x} = 0, \ \left. \frac{\partial T}{\partial y} \right|_{y=0,L_y} = 0, \ (8)$$

$$-\lambda \frac{\partial T}{\partial z}\Big|_{z=0} = \begin{cases} q(t), ecnu(x, y) \in \Pi_{I}, \\ 0, ecnu(x, y) \in \Pi - \Pi_{I}^{2} \end{cases}$$
$$T\Big|_{z=L_{z}} = 0. \tag{9}$$

Решение этой задачи будет

$$T(x,y,z,t) = \frac{4q(t)}{L_x L_y \lambda} (L_z - z) \sum_{m,n=l}^{\infty} A_{nm} \cos\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) \cos\left(\frac{m\pi y}{L_y}\right) + \frac{8a}{L_x L_y L_z \lambda} \otimes$$

$$\sum_{k=lm,n=l}^{\infty} \sum_{m=l}^{\infty} A_{nm} \cos\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) \cos\left(\frac{m\pi y}{L_y}\right) \cos\left(\frac{(2k-l)\pi z}{2L_z}\right) \int_{0}^{t} q(\tau) \exp\{-a\gamma_{nmk}(t-\tau)\} d\tau,$$
(10)

где

$$A_{nm} = \frac{L_x L_y}{nm \pi^2} \sin\left(\frac{n \pi l_x}{L_x}\right) \sin\left(\frac{m \pi l_y}{L_y}\right);$$

$$\gamma_{nmk} = \left(\frac{n \pi}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{m \pi}{L_y}\right)^2 + \left(\frac{(2k-1)\pi}{L_z}\right)^2.$$

Расчёт нестационарных режимов работы термоэлементов проводился по методике, представленной в работе [3]. Согласно её, процесс установления температур холодной и горячей граней можно описать экспоненциальным законом при следующих модельных допущениях: 1) рабочий ток необходимо ограничивать максимальным током $I_{max} = \alpha T_c / R$, где $\overline{\alpha}$ - средний коэффициент термоэдс термоэлемента в рабочем интервале температур, Т_с – температура холодной грани, R – сопротивление термоэлемента; 2) отбор (подвод) тепла от полупроводникового материала и охлаждаемых (нагреваемых) тел считать объёмным. Составляя дифференциальные уравнения баланса тепла для граней термоэлемента и охлаждаемых и нагреваемых тел, можно получить их решения в виде следующих функций

$$T_{c} = \frac{A}{B} + \left(T_{0} - \frac{A}{B}\right) exp(-|\lambda_{1}|t),$$
$$T_{h} = \frac{C}{B} - \left(\frac{C}{B} - T_{0}\right) exp(-|\lambda_{2}|t).$$
(11)

где T_h – температура горячей грани термоэлемента, А, В, С, l, l, – постоянные коэффициены. Коэффициенты А и С зависят от температуры охлаждаемой (нагреваемой) среды, то есть А(Т_) и С(Т_). Итерационный алгоритм расчёта \tilde{T}_{c} , T_{h} , \tilde{u}^{T}_{π} состоит из следующих операций. Для первого приближения нахождения T_{...}(t) используется линейный закон охлаждения по заданной скорости v. На дискретных промежутках времени находятся значения Т_с и Т_ь из выражений (11). Далее используя те же выражения, по найденным ранее значениям температур горячей и холодной граней термоэлемента, решается обратная задача по нахождению температуры жидкости. Процесс повторяется до тех пор, пока относительная ошибка предыдущего и последующего значений не будет превышать заданного предельного значения. При вычислении температуры горячей грани учитывается средняя температура аккумулятора холода, либо термоаккумулирующей пластины, которая вычисляется по формуле

$$\langle T(t) \rangle = \frac{1}{V} \iiint_{v} T(x, y, z, t) dx dy dz$$
, (12)

где V – объём аккумулятора или пластины.

Исходя из основных уравнений теории термоэлектрического охлаждения [4], необходимые для вычислений термоэлектричес-

кие величины $\overline{\alpha}$ и комплекс $\frac{\overline{\alpha}^2}{RZ}$, где Z –

эффективность полупроводникового вещества термоэлемента, можно выразить через его паспортные данные, а именно максимальную разность температур между холодной и горячей гранью DT_{max} при холодопроизводительности $Q_0 = 0$ и соответствующих ей величин тока I_{max} и напряжения U_{max} :

$$\frac{\overline{\alpha}^2}{RZ} = \frac{RI_{max}^2}{2\Delta T_{max}}, \ \overline{\alpha} = \frac{(U_{max} - I_{max}R)}{\Delta T_{max}}.$$
(13)

При проведении расчётов был выбран термоэлемент ТВ-127-1,4-2,5. Его паспортные данные: I_{max}=3,7A, Q_{max}=37,00Вт, U_{max}=16,3B, DT_{max}=72K R=3,2Oм. Расчёты проводились для декана, помещённого в кювету из латуни. Материалами аккумулятора холода и термоаккумулирующей пластины были алюминий и медь соответственно. Все необходимые для расчётов физические характеристики определялись из [5]. Температура окружающей среды и начальная температура равнялись $T_{cp} = 24$ °C и $T_0 = -15$ °C соответственно. На рис. 4 представлено распределение температуры по длине аккумулятора холода ($z = L_z/2$) для различных моментов времени. Видно, что максимальное превышение температуры, по отношению к начальной, составляет порядка 7 °C за 5 секунд, после чего температура горячей грани 2-го термоэлемента выходит на стационарный режим (рис. 5) и дальнейшее повыше-



Рис. 4. Распределение температуры по половине длины (х) аккумулятора холода: z = L_z/2 = 20мм; t : 1–2, 2-3, 3-4, 4-5 с





ние температуры аккумулятора холода не происходит. Зависимость температуры жидкости от времени представлена на рис. 6. При увеличении скорости охлаждения v, для 1-ой схемы, наблюдается минимум в распределении температуры, величина которого увеличивается с увеличением скорости. Это определяется теплоинерционностью аккумулятора холода. При равных скоростях охлаждения, использование второй схемы приводит к достижению более низких температур в стационарном режиме, что объяснимо лучшими условиями теплоотдачи. Кроме того, вторая схема отличается, в лучшую сторону, значительно меньшим энергопотреблением, меньшими габаритами и весом, проще в реализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конторович М. Л., Соломин Б. А., Черторийский А. А. и др. Способ исследования низкотемпературных свойств многокомпонентных жидкостей и устройство для его осуществления. Патент № 2183323 от 10.06.2002.
- Карташов Э. М. Аналитические методы в теории теплопроводности твёрдых тел. М. : Высш. школа, 1985.
- Покорный Е. Г., Щербина А. Г. Расчёт полупроводниковых охлаждающих устройств. Л. : Наука, 1969.
- Бурштейн А. И. Физические основы расчёта полупроводниковых термоэлектрических устройств. М.: ГИФМЛ, 1962.
- 5. Физические величины. Справочник / Под ред. Григорьева И. С., Мейлихова Е. З. М. : Энергоатомиздат, 1991.

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF CIRCUITS THERMO-FREEZING DEVICES IN INSTALLATION FOR RESEARCH HEAT-TRANSFER PROPERTIES OF LIQUIDS IN CONDITIONS OF NONEQUILIBRIUM THERMODYNAMICS

© 2008 B.A. Solomin, A.M. Hodakov

Ul'yanovsk Branch of Institute of Radio Engineering and Electronics of Russian Academy of Science

It is made heat-transfer calculation of two circuits of cooling devices on elements Peltje working in a dynamic mode. Advantage of one of circuits is shown.